## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:	
Takenori SEKIJIMA et al.	
Serial No.: Currently unknown	
Filing Date: Concurrently herewith	
For: DHOTOMAGNETIC FIELD SENSOD	

## TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENTS

Mail Stop PATENT APPLICATION Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Enclosed herewith is a certified copy of each of Japanese Patent Application No. 2002-275989 filed September 20, 2002, from which priority is claimed under 35 U.S.C. 119 and Rule 55b. Acknowledgement of the priority document is respectfully requested to ensure that the subject information appears on the printed patent.

Respectfully submitted,

Date: August 18, 2003

Atterneys for Applicant(s)

Joseph R. Keating

Registration No. 37,368

Christopher A. Bennett Registration No. 46,710

**KEATING & BENNETT LLP** 10400 Eaton Place, Suite 312 Fairfax, VA 22030

Telephone: (703) 385-5200

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2002年 9月20日

出 願 番 号

Application Number:

人

特願2002-275989

[ST.10/C]:

[JP2002-275989]

出 願 Applicant(s):

株式会社村田製作所

2003年 7月 3日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

32-0839

【提出日】

平成14年 9月20日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G01R 33/032

G02B 6/12

G02F 1/09

【発明者】

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

関島 雄徳

【発明者】

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

下方 幹生

【発明者】

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

藤井 高志

【特許出願人】

【識別番号】

000006231

【住所又は居所】

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

【氏名又は名称】

株式会社村田製作所

【代表者】

村田 泰隆

【電話番号】

075-955-6731

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

005304

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

光磁界センサ

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 常磁性体からなるファラデー回転子と、

偏光子と、検光子と、光照射手段と、光感知手段とを具備する光磁界センサであって、

前記常磁性体からなるファラデー回転子が少なくともTbとAlとを含む常磁性体ガーネット単結晶からなることを特徴とする光磁界センサ。

【請求項2】 常磁性体からなるファラデー回転子と、偏光子と、検光子と、 光照射手段と、光感知手段とを具備する光磁界センサであって、

前記常磁性体からなるファラデー回転子が円柱状であり、前記ファラデー回転子の円柱の直径 (mm) をA、ファラデー回転子の一端面から他端面までの距離 (mm) をBとしたとき、0 < A  $\leq$  2 かつ 1  $\leq$  B / A  $\leq$  1 0 であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の光磁界センサ。

【請求項3】 前記常磁性体からなるファラデー回転子が、少なくともTbと A1とを含む常磁性ガーネット単結晶であって、前記Tbの一部がPr及びCeの少なくとも一方で置換されていることを特徴とする請求項1または請求項2 に記載の光磁界センサ。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【従来の技術】

近年、電力分野において、落雷等による送電線の異常電流検知用センサとして、磁気光学材料を用いた光磁界センサが注目されている。これは送電線周囲に発生する磁界を、磁気光学効果の一種であるファラデー効果を用いて検知するものあり、磁界の大きさによって、ファラデー回転子のファラデー回転角が変化することを利用するものである。以下に具体的に説明する。一般的にファラデー効果を有するファラデー回転子に対してレーザー光を照射し、レーザー光の進行方向と同一方向に磁界が発生すると、磁界の強度に比例して入射したレーザー光の偏光面が回転することが知られている。このような性質を利用し、光の進行方向に

沿ってファラデー回転子の前後に、異なる偏光面を有する偏光子を設けることによって、一方の偏光子を介してファラデー回転子に入射したレーザー光の光量と、ファラデー回転子を通過し、他方の偏光子を出射するレーザー光の光量に差が生じることになる。この光量の差をフォトディテクタ等の光感知手段にて検知することによって、異常電流の大きさを検知することが可能となる。

## [0002]

このようなファラデー効果を利用した光磁界センサは、高感度であり、かつ小型・軽量化が可能であるほかに、光を媒体とするため防爆性に優れ、遠隔操作も可能である。さらに、光の伝搬に光ファイバを用いているため、耐電磁誘導、雑音性、及び絶縁性に優れており、電気式磁界センサにはない優れた特徴を有している。

## [0003]

上記のような光磁界センサに用いられるファラデー回転子の磁性材料の特性として、ヴェルデ定数(V: (deg/(Oe·cm))が大きいことが求められている。ヴェルデ定数とは単位長さ単位印加磁場あたりのファラデー回転角を意味し、偏光した光の回転角度を示すファラデー回転角(θ)、ファラデー回転子を通る光の移動距離(d)、及びファラデー回転子にかかる磁界強度(H)から、θ=VHdの関係で表される。このことから、ヴェルデ定数が大きいほど、ファラデー回転角が大きくなる。その結果、磁場強度の変化により、磁場のかかるファラデー回転角の変化する割合も大きくなるため、レーザー光の入射光と出射光の光量の差が大きくなり、より高感度の光磁界センサを得ることが可能となる。

#### [0004]

[0005]

#### 【特許文献1】

特開平5-72307号公報 (3頁~4頁)

[0006]

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、特開平5-72307号公報に記載されるYIG単結晶は、ある磁場強度まではファラデー回転角が大きくなるが、ある磁場強度を過ぎるとファラデー回転角が一定になり磁気飽和するという問題があった。このため、大電流を検知する光磁界センサのファラデー回転子として用いた場合、正確な電流検知を行うことができないという問題を有していた。また、YIG単結晶は、光の波長領域が1100nm~5000nmの赤外線領域の光しか透過できず、650nmという可視光域のプラスチックファイバを用いることができないため莫大なコストがかかるという問題があった。

#### [0007]

本発明の目的は、上述の問題点を解決するべくなされたもので、大電流領域、 すなわち磁界強度の高い領域においても、感度が高く、500~650nmとい った可視光領域の波長を有する光を用いても感知可能な光磁界センサを提供する ことにある。

[0008]

#### 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本願第1の発明の光磁界センサは、常磁性体からなるファラデー回転子と、偏光子と、検光子と、光照射手段と、光感知手段とを具備する光磁界センサであって、前記常磁性体からなるファラデー回転子が少なくともTbとA1とを含む常磁性体ガーネット単結晶からなることを特徴とする

[0009]

本発明者らは、ヴェルデ定数が高く、ファラデー回転角が飽和しない上に、500-650nmという可視光領域の波長を透過可能なファラデー回転子として、Tb2A1とを含むテルビウム・アルミニウム系常磁性体ガーネット( $Tb_3A1_5O_{12}$ ;以下、TAGと略す)が適していることを見出し、COTAG単結晶を光磁界センサのファラデー回転子として用いることを可能としたのである。

より具体的に説明すると、そもそもTAG単結晶は分解溶融型化合物であるため、出発原料を溶融した溶融組成から、直接ガーネット相であるTAG単結晶を得られず、TAG単結晶のほかにペロブスカイト相のTbA1〇3が混在してしまうという問題を有していた。しかし、本発明者らは鋭意検討した結果、CO2ガスレーザーを用いて、融帯に強力な光エネルギーを与えることにより、光磁界センサに適したTAG単結晶を得ることに成功したのである。このようなTAG単結晶をファラデー回転子とした光磁界センサを用いることによって、ファラデー回転角が飽和せず、大電流においても感度が高く、かつ500~650nmという可視光領域の波長を有する光を用いても感知可能な光磁界センサを得ることができる。

## [0010]

また、本願第2の発明の光磁界センサは、常磁性体からなるファラデー回転子 と、偏光子と、検光子と、光照射手段と、光感知手段とを具備する光磁界センサ であって、前記常磁性体からなるファラデー回転子が円柱状であり、前記ファラ デー回転子の円柱の直径をA、ファラデー回転子の一端面から他端面までの距離 をBとした時、O<A≦2かつ1≦B/A≦10であることが好ましい。このよ うな形状のファラデー回転子を用いることによって、ファラデー回転子の一端面 から他端面までの長さ、すなわちファラデー回転子を通る光の移動距離が大きく なるため、ファラデー回転子のファラデー回転角を大きくすることができる。こ れにより、さらに高感度な光磁界センサを得ることができる。また、ファラデー 回転子の一端面から他端面までの距離が大きい方が、ファラデー回転子内におけ る反磁界を小さくすることができる。すなわち、ファラデー回転子は磁性体であ るため、ファラデー回転子に外部から磁化が印加されると、ファラデー回転子内 には外部磁界とは逆方向に磁界(反磁界)が生じる。すると、実際には外部磁界 から反磁界を差し引いた磁界分を検知することになり感度が悪くなるという問題 が生じる。そこで、第2の発明のようにファラデー回転子の一方の端面から他方 の端面までの距離を大きくすることによって、ファラデー回転子内に生じる反磁 界の影響を抑制することができる。

[0011]

また、本願第3の発明の光磁界センサは、前記ファラデー回転子が、少なくともTbと、A1と、Ce及びPrの少なくとも一方と、を含む常磁性ガーネット単結晶からなることが好ましい。このようなファラデー回転子を用いた場合、ヴェルデ定数がより大きくなるため、さらにファラデー回転角を大きくすることができる。その結果、より高感度な光磁界センサを得ることができる。

[0012]

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明の光磁界センサの一実施形態について図1を用いて説明する。なお、ここでいう光軸とは光の伝搬路を説明するための一般的な意味で用いられる。また、ここでいう入射とは、光源から照射された光が最初に光磁界センサに入る向きを示し、出射とはその光が光磁界センサから出てくる向きを示す。図1は本発明の光磁界センサの概略構成図を示している。この光磁界センサ1は、ファラデー回転子2と偏光子3と検光子4と光照射手段5、光感知手段6とを具備している。

## [0013]

ここで、ファラデー回転子2の入射側に偏光子3を設け、ファラデー回転子2の出射側に検光子4が光軸方向に並列に配置され、偏光子3及び検光子4は、ファラデー回転子2を通る光軸がその偏光面を通過するよう、それぞれの偏光面が光軸に対して垂直となるように設けられている。また、光照射手段5は偏光子3に光を入射できる位置に設けられていればよい。すなわち、光照射手段5は必ずしもファラデー回転子2を通る光軸に沿って設けられる必要がなく、例えば光照射手段5と偏光子3との間に全反射ミラー7aを設けることによって光を反射させてその光路を変えることも可能である。このように光照射手段5と偏光子3との間に全反射ミラー7aを設けることで、光磁界センサ1としては小型化が可能となる。また、光照射手段5と偏光子3との間に設けられる全反射ミラー7aと同様の理由で、検光子4と光感知手段6との間に全反射ミラー7bを設けてもよい。さらに、全反射ミラー7aと偏光子3、及び全反射ミラー7bと検光子4との間に、それぞれ集光レンズ8a及び8bを設けることが可能である。この場合、集光レンズ8aを設けることによって、ファラデー回転子2に効率良く光を入

射させることができる。また、集光レンズ8bを設けることによって、光感知手段6に効率良く光を送ることができる。

## [0014]

ここで用いられるファラデー回転子 2 は、少なくともTbとA 1 とを含むテルビウム・アルミニウム系常磁性ガーネット単結晶からなる。具体的には、Tb3 A  $1_5$ O $_{12}$ 、またはTb $_3$ A  $1_5$ O $_{12}$ のTbサイトをCe、Pr、Dy、Ho、Er、及びTm等の希土類元素で置換したものを用いてもよいが、ヴェルデ定数が大きく、400~650 n mという可視光領域においても好適な光透過率を得るにはTb $_3$ A  $1_5$ O $_{12}$ が好ましい。さらに好ましくは、Ce 及びPrの少なくともいずれか一方をTAG単結晶のTbサイトに置換したものが好ましい。この場合、近紫外光域にファラデー効果増大に寄与する吸収端が存在するという理由でヴェルデ定数が大きくなることがわかった。これにより、ファラデー回転角が大きくなるため、光磁界センサ1の感度を高めることができる。

## [0015]

また、ファラデー回転子2の形状は、例えば棒状、薄板状、及び薄膜状等の形状を用いることができるが、中でも円柱状であることが好ましい。これは得られた単結晶の形状が円柱状であるため、加工が容易であり、かつ電流によって生じた磁場がファラデー回転子2内に均一にかかりやすいためである。

#### [0016]

また、ファラデー回転子2のサイズは、目的とするセンサの種類や、ファラデー回転子2となるTAG系単結晶のヴェルデ定数をもとに設定すればよいが、ファラデー回転子2の円柱の直径をAmm、ファラデー回転子2の一端面から他端面までの距離をBmmとした時、O<A≦2かつ1≦B/A≦10であることが好ましい。なお、ここでいうファラデー回転子2の端面とは、ファラデー回転子2の光軸に対して垂直な面であり、光が入射及び出射する面を示す。このような構成にすることで、ファラデー回転角を大きくすることができ、光磁界センサ1としての感度を高めることができる。なお、Aが2よりも大きいと、外部磁界がファラデー回転子2内に均一に印加されないという問題が生じる。また、B/Aが1よりも小さいと、ファラデー回転子2の一端面から他端面までの距離が短く

、反磁界が大きくなるため好ましくない。また、B/Aが10よりも大きい場合 、ファラデー回転子2を移動する光の距離が長くなり、光透過率が低下するため 好ましくない。

### [0017]

また、本発明の偏光子3、及び検光子4の各入出射面が、ファラデー回転子2を通過する光軸に対して垂直となり、かつ光軸方向に沿ってファラデー回転子2の前後に設けられている。そして、偏光子3の偏光面と、検光子4の偏光面とが45°の角度をなすように配置されていることが好ましい。この関係を図3を用いて説明する。図3の横軸は偏光子3と検光子4とがなす角度を示し、縦軸が検光子4から出射される光量を示す。この曲線の各角度における接線を引いたとき、その接線の傾きが光量の透過率を示すが、図3より45°の角度の時に一番効率よく磁場変動を透過可能な光量に変換できることがわかる。また、偏光子3及び検光子4として、延伸ポリマー、もしくはルチル及び方解石(CaCO<sub>3</sub>)等からなる単結晶偏光子等を用いることができる。また、細い金属製ワイヤを複数個用意し、隣合う各ワイヤが一定方向に平行となるように並べて板状にしたものを用いることもできる。

## [0018]

また、光照射手段5として、ルビーレーザ、He-Neレーザ、Arレーザ、He-Cdレーザ、InGaN半導体レーザ等を用いることができるが、これに限るものではない。この中でもHe-Neレーザは波長が633nmと可視光域に対応でき、プラスチックファイバの波長領域に近いため、より好適に用いられる。また、光感知手段6として、フォトディテクタを用いることが好ましい。その他にもSi、InGaAs等の受光素子を用いることができるがこれに限るものではない。

#### [0019]

また、本発明の全反射ミラー7a及び7bは、その反射面が入射光、かつファラデー回転子2の光軸に対して45°の角度で配置されることが好ましい。このような構成にすることによって、例え光源がファラデー回転子2の光軸方向に沿って設けられていなくても、入射した光が漏れなくファラデー回転子2の中心に

向かって入射され、より正確な磁場強度の感知が可能となる。なお、全反射ミラー7a及び7bとしてA1、Au等を用いることが好ましく、その中でもA1が好ましい。A1は可視光に対して反射率が最も高い材料であるため、光エネルギーの損失を極力小さくできる。

## [0020]

また、本発明の集光レンズ8 a はビームウェストがファラデー回転子2の中心を通るように、調整されて配置されている。これは入射する光がファラデー回転子2に最も効率よく入射できるようにするためである。集光レンズ8 a 及び8 b としては、両凸レンズ、ボールレンズ等を用いることができるが、これに限るものではない。

## [0021]

ここで、ファラデー回転子の側部に磁場を発生させる永久磁石を取り付けた羽根車が配置されていると仮定し、磁場がファラデー回転子の光軸に対して平行下に印加されている場合の上記光磁界センサの作用を説明する。まず、光照射手段5から照射された光は、全反射ミラー7aにおいて、反射された光がファラデー回転子2を通る光軸と平行となるように90°反射される。そして、反射された光は集光レンズ8bにより集光され、偏光子3を介して偏光子3と同じ偏光面を有する光が、ファラデー回転子2に入射される。ここで、ファラデー回転子2の中心を通る光軸と平行となるように、磁界が印加されている。これにより、入射された光の偏光面はファラデー効果によりファラデー回転子2の中で光の進行方向に対して、ファラデー回転角の大きさほど回転する。そして、ファラデー回転子2を出射した光は、検光子4を介して検光子4と同じ偏光面を有する光だけ出射されることになる。検光子4を出射した光は集光レンズ8bを介して光の幅を広げていき、その光線を全反射ミラー7bにおいて、光軸に対して90°反射される。さらに反射した光は感知手段6において、その光量を感知されることになる。

## [0022]

また、以下に本発明の光磁界センサの別の実施形態について図2を用いて説明 する。図2は本発明の別の光磁界センサの概略構成図を示している。この光磁界 センサ11は、ファラデー回転子12と偏光子13と光照射手段15と光感知手段16と全反射ミラー17と集光レンズ18と偏光プリズム19とから構成されている。ここではファラデー回転子12のうち、光が入射する一端面に偏光子13が並設されており、他端面に全反射ミラー17が蒸着されている。そして光照射手段15からファラデー回転子12までの間に、光軸方向に沿って偏光プリズム19と集光レンズ18とが配置されている。このような構成にすることにより、図1で示す一つの実施の形態よりも、構成数を少なくすることができ、より小型の光磁界センサ11を提供することができる。

#### [0023]

この場合のファラデー回転子12、偏光子13、全反射ミラー17、及び集光レンズ18は図1に示す一実施の形態と同様のものを用いることができる。また、ここにおける偏光プリズム19は、入射してきた入射光に対しては直進するが、全反射ミラー17によって反射してきた反射光は入射光に対して直角方向に反射させるように配置される。このように配置することで、入射光と反射光とを分離することができ、正確な光量を測定できる。偏光プリズム19としては方解石等を用いることができる。

#### [0024]

ここで、図2で示される別の実施形態である光磁界センサ11の作用を具体的に説明する。なお、ファラデー回転子の側部に磁場を生じさせる永久磁石付き羽根車が配置されていると仮定し、磁場がファラデー回転子の光軸に対して平行に印加されている場合の図2に示す光磁界センサの作用を具体的に説明する。ここで光照射手段15から照射された光は、まず偏光プリズム19を通過する。ここで光は光軸に平行な方向に通過する。そして、偏光プリズム19を通過した光は集光レンズ18を介して集光され、偏光子13が併設されたファラデー回転子12に入射する。ここで偏光子13と同じ偏光面を有する光が通過する。そして、ファラデー回転子12のなかで、ファラデー効果によりその偏光面をファラデー回転角の大きさ分だけ回転されることになる。この回転された偏光面を有する光が、ファラデー回転子12の他端面に形成された全反射ミラー17によって180。反射され、ファラデー回転子12を再度通過することになる。ここで反射光

は、入射光とは逆向きに磁界を感じファラデー効果の非相反性により、さらに入射光の光軸に対してファラデー回転角の大きさ分だけ偏光面が回転されることになる。そして偏光子13を介し、偏光子13と同じ偏光面を有する反射光が出射される。そして偏光子13から出射された反射光は、再度集光レンズ18を介して光線幅を広げながら直線光となり、偏光プリズム19に入射する。ここで、偏光プリズム19に入射した反射光は光軸方向に対して直角方向に反射され、光感知手段16により光量を感知される。

[0025]

(実施例1)

以下、本願発明の一実施の形態をより具体的に説明する。

## 1. TAG単結晶の作製

まず、常磁性ガーネット多結晶の出発原料として、Tb4O7(純度99.9%) 及びA12O3(純度99.99%)を用意しTb3A15O12となるように秤量する 。この混合量、及び組成比は、所望のヴェルデ定数に合わせて適宜変更すること ができる。次に調合した出発原料の混合粉末に純水を加えて玉石とともに約24 時間混合し、混合された混合粉末を脱水した後に乾燥機で乾燥させる。そして乾 燥された混合粉末をメッシュに通して混合粉末の粒度を調整し、電気炉を用いて 1200℃で2時間の仮焼を行う。この仮焼して得られた混合粉末を粉砕した後 、混合粉末に有機バインダ及び溶剤を加えて玉石とともに数時間混合した後、ス ラリー状の混合物を得る。この混合物を成形機で円柱状に成形した後、電気炉に おいて1600℃2時間で焼成し、円柱状のTAG多結晶体を得る。次に、得ら れた円柱状のTAG多結晶体と種結晶としてTAG単結晶とを用意して、CO2 レーザーFZ (Floating Zone) 装置に設置し、大気中雰囲気においてCO2レー ザー光を照射してTAG多結晶体の端部を加熱し溶融させ、TAG多結晶体の溶 融部分と種結晶の端部とを接合させる。続いて、TAG多結晶体の端部と種結晶 の端部との接合部においてCO2レーザー光を照射するとともに、TAG多結晶 体をさらに加熱溶融させて溶融物を得、冷却させることにより、TAG単結晶を 得られる。

[0026]

## 2. 光磁気センサの作製

次に上記のようにして得られたファラデー回転子の長さ1 mm、かつ断面の直径が1 mmの円柱状に加工した。ここで、ファラデー回転子の直径に対する一端面から他端面までの長さは(B/A)は1であった。次に、ルチルからなる偏光子及び検光子と、合成石英からなる集光レンズを2つ用意し、光の入射方向から順に集光レンズ、偏光子、ファラデー回転子、検光子、及び集光レンズとなるように、光軸方向に沿って配置した。光照射手段と集光レンズとの間、及び光感知手段となるフォトディテクタと集光レンズとの間に全反射ミラーを設け、光照射手段から照射された光が全反射ミラーにおいて90°反射され、反射された光がファラデー回転子と平行となるような位置に光照射手段を設けた。また、ファラデー回転子から出射された光が全反射ミラーによって90°反射する位置に光感知手段を設けた。このように図1に示される構成を有する光磁界センサを実施例1とした。

#### [0027]

また、上記のような構成の実施例1以外に、以下のような実施例2、3、及び 比較例1~3の光磁界センサを作製した。

## (実施例2)

ファラデー回転子として $(Tb_{2.8}Ce_{0.2})Al_5O_{12}$ で表されるTAG系単結晶を用いた以外は実施例1と同様の構成の光磁界センサを作製し、これを実施例2とした。(なお、Tbの一部をCeで置換したTAG系単結晶は可視光域が525~680nmに適したものである。)

### (実施例3)

ファラデー回転子として $(Tb_{2.8}Pr_{0.2})Al_5O_{12}$ で表されるTAG系単結晶を用いた以外は実施例 1 と同様の構成の光磁界センサを作製し、これを実施例 3 とした。

#### (比較例1)

ファラデー回転子として $Y_3$   $Fe_5$   $O_{12}$  単結晶を用いた以外は実施例 1 と同様の構成の光磁界センサを作成し、これを比較例 1 とした。

#### (比較例2)

ファラデー回転子としてファラデーガラスを用いた以外は実施例1と同様の構成の光磁界センサを作成し、これを比較例2とした。

## (比較例3)

ファラデー回転子としてBi $_{12}$ GeO $_{20}$ で表される単結晶を用いた以外は実施例1と同様の構成の光磁界センサを作成し、これを比較例3とした。

上記のようにして得られた実施例1~3、及び比較例1~3について、以下のような特性評価を行った。

まず、実施例  $1 \sim 3$ 、及び比較例  $1 \sim 3$  において用いられたファラデー回転子のヴェルデ定数を測定した。各長さ(t)が 1 mmのファラデー回転子に磁場(H)を 1 k O e 印加しながら、ランプコート分光器を用いて波長領域が 4 O O  $\sim$  6 8 O n mのレーザー光をファラデー回転子に照射した。このレーザー光に平行となるように磁場を印加しながら、出射されたファラデー回転角( $\theta$ )を測定し、 $V = \theta /$ (t  $\times$  H)の式に代入してヴェルデ定数を求めた。その結果を表 1 に示す。

## [0028]

次に、実施例1~3、及び比較例1~3のそれぞれの光磁界センサについて磁場変動を測定した。まず、各光磁界センサのファラデー回転子の側部に、先端に磁石を有する羽根車を設置し、この羽根車をモータにより回転させることによって、磁場の変動を生じさせた。このときの磁場変動を図4に示す。そして、HeーNeレーザ(波長が633nm)を用いて各光磁界センサのレーザ光を照射した。このとき、磁場変動に合わせてファラデー回転子から出射される光量の変化を、フォトディテクタを用いて測定した。このときの光量の変化を、実施例1~3、及び比較例1~3の順に図5~図10に示す。

[0029]

【表1】

波長	ヴェルデ定数 V(d gr ・0 -'・cm-')					
(nm)	実施例1	実施例2	実施例3	比較例1	比較例2	比較例3
400	0.035	-	0.018		0.017	0.026
405	0.033	-	0.016	_	0.016	0.023
410	0.032	-	0.032		0.015	0.022
420	0.030	_	0.031		0.014	0.021
525	0.022	0.025	0.027		0.011	0.016
575	0.018	0.021	0.023	_	0.009	0.013
633	0.010	0.012	0.014		0.005	0.007
680	0.008	0.009	0.010		0.004	0.006

[0030]

表1から、実施例1~3については525~680nmという可視光領域において、高いヴェルデ定数を有していることがわかる。特に、TAG単結晶のTbサイトにCe、もしくはPrを置換した、実施例2及び実施例3はヴェルデ定数が高くなっていることがわかる。また、実施例1及び実施例3については、400~500nmという可視光領域の光にも十分に対応できることが明らかである。一方、比較例1は、ファラデー回転子に400~650nmの光を照射しても、YIG単結晶が光を吸収してしまい、ファラデー回転角を測定することができなかった。また、比較例2は実施例1の約1/2、比較例3は実施例1の約70%のヴェルデ定数しか得られなかった。

## [0031]

また、磁場変動を示す図4、及び実施例1の光磁界センサが感知する光量を示す図5において、ファラデー回転子にかかる磁化変動を示す曲線と、フォトディテクタが感知する光量を示す曲線とが同じ波形を示すことがわかる。このことから、磁場変動を漏れなく光量に変換していることがわかる。また、実施例1はヴェルデ定数が大きく、光量の差も大きいため、光磁界センサとして感度が高いことがわかる。また、実施例2を示す図6及び実試料3を示す図7も実施例1と同様に光量の差が大きく、光磁界センサとして感度が高いことがわかる。一方、比較例1を示す図8は、磁場の大きさが3500eを超えると、磁気飽和に達するためファラデー回転角が一定になり、3500e以上の磁場の大きさになると光量も一定になる。また、比較例2を示す図9、及び比較例3を示す図10におい

ては、ともに常磁性材料をファラデー回転子として用いているが、磁場変動に対 して得られる光量が少ないため、光磁界センサとしては性能が劣ることがわかる

なお、実施例1については円柱状のファラデー回転子の端面の直径が1mm、ファラデー回転子の一端面から他端面までの長さが1mmであるため、反磁界の影響を抑制できている。

[0032]

#### 【発明の効果】

以上述べたように、本願第1の発明である光磁界センサを用いることによって、大電流においても感度が高く、かつ500~650nmという可視光領域の波長を有する光を用いても感知可能な光磁界センサを得ることができる。

また、本願第2の発明である磁器光学センサを用いることによって、ファラデー回転子にかかる磁場が大きくなるため、さらにファラデー回転角を大きくすることができる。これにより、より高感度な光磁界センサを得ることができる。

また、本願第3の発明である磁器光学センサを用いることによって、ファラデー回転子の端面から端面までの長さ、すなわちファラデー回転子を通る光の移動 距離が大きくなるため、ファラデー回転子のファラデー回転角を大きくすること ができ、かつファラデー回転子が有する反磁界の影響を抑制することができる。 これにより、さらに高感度な光磁界センサを得ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明にかかる一実施形態の光磁界センサの概略構成図である。
- 【図2】本発明にかかる別の実施形態の光磁界センサの概略構成図である。
- 【図3】本発明における偏光子と検光子とがなす角度と、偏光子及び検光子を 通過する光量との相関図である。
  - 【図4】実施例1~3、及び比較例1~3における磁場ー時間特性図である。
  - 【図5】実施例1の光量-時間特性図である。
  - 【図6】実施例2の光量-時間特性図である。
  - 【図7】実施例3の光量-時間特性図である。
  - 【図8】比較例1の光量ー時間特性図である。

## 【図9】比較例2の光量-時間特性図である。

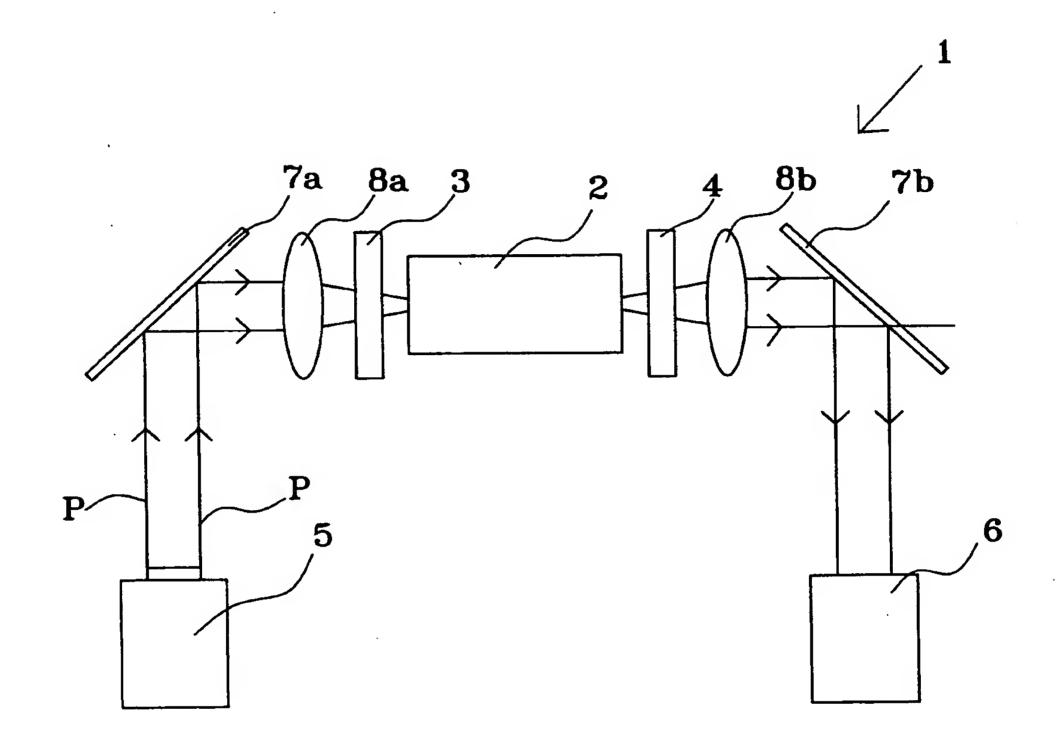
## 【図10】比較例3の光量-時間特性図である。

## 【符号の説明】

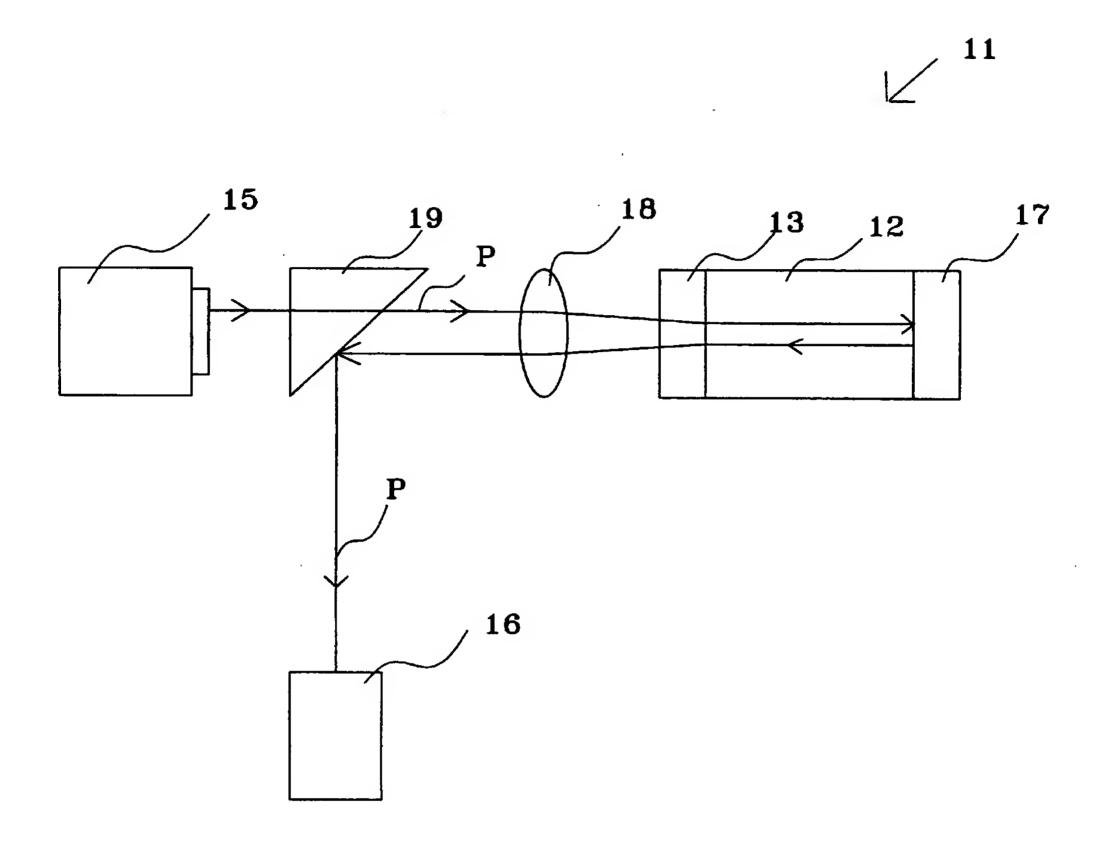
- 1 光磁界センサ
- 2 ファラデー回転子
- 3 偏光子
- 4 検光子
- 5 光照射手段
- 6 光感知手段
- 7 全反射ミラー
- 8 集光レンズ
- 11 光磁界センサ
- 12 ファラデー回転子
- 13 偏光子
- 15 光照射手段
- 16 光感知手段
- 17 全反射ミラー
- 18 集光レンズ
- 19 偏光プリズム
- P 光の通過経路

## 【書類名】図面

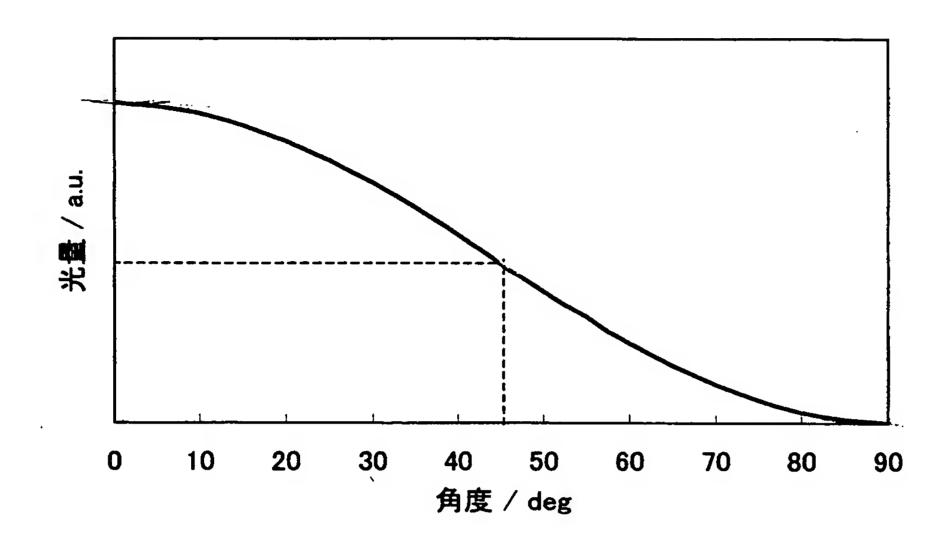
## 【図1】



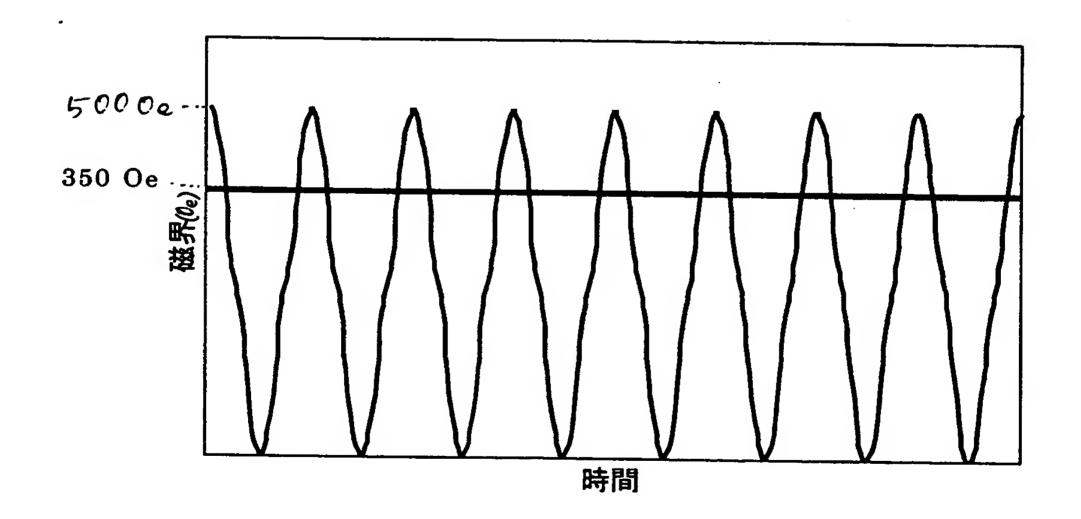
## 【図2】



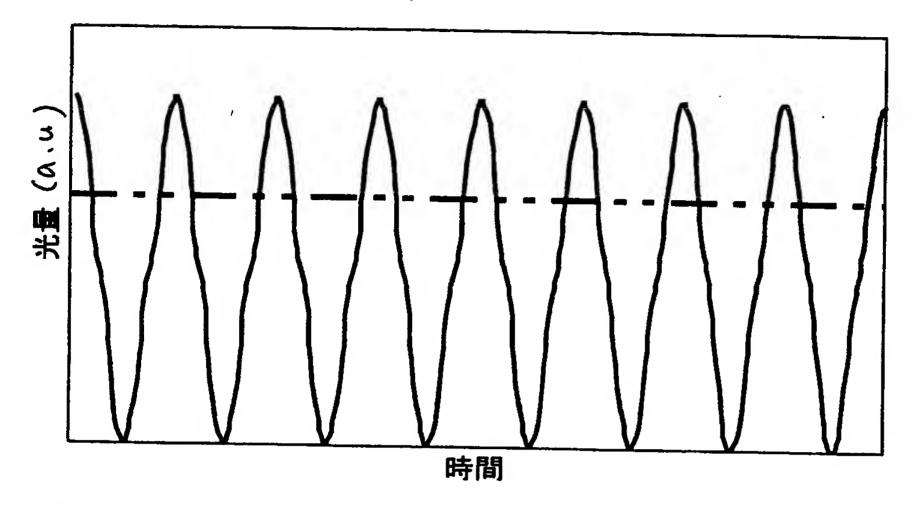
【図3】



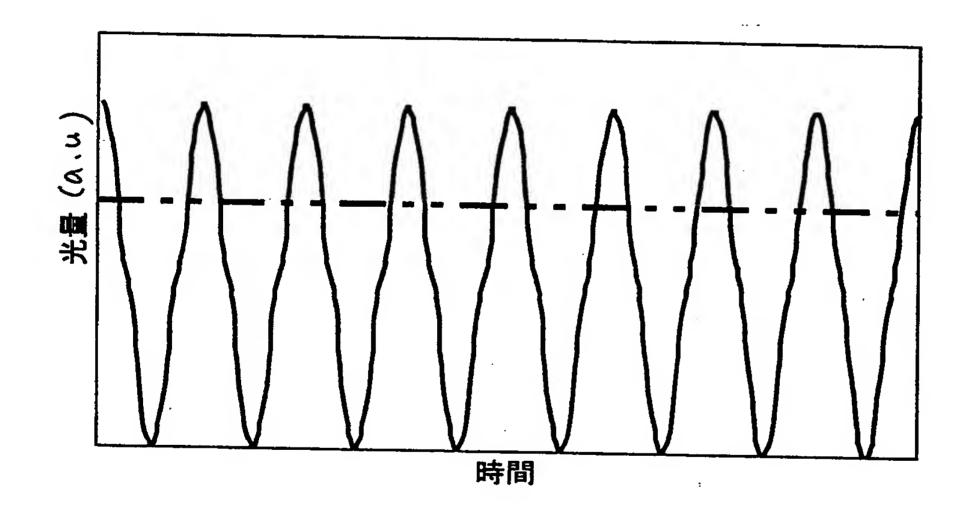
【図4】



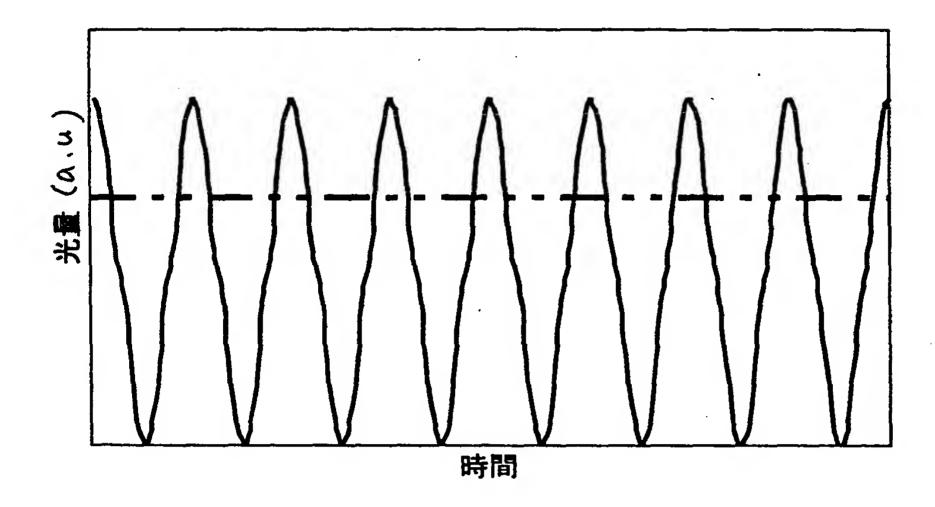
【図5】



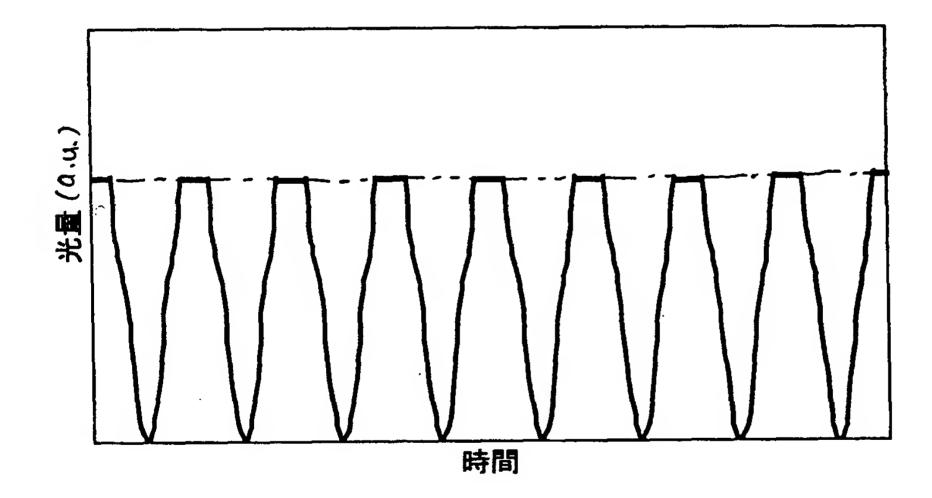
【図6】



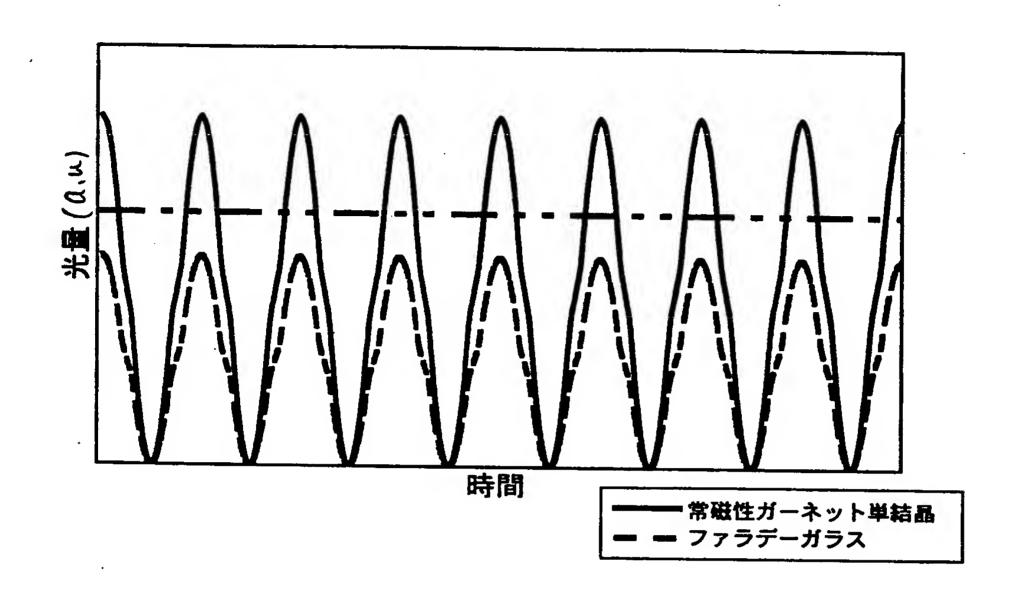
【図7】



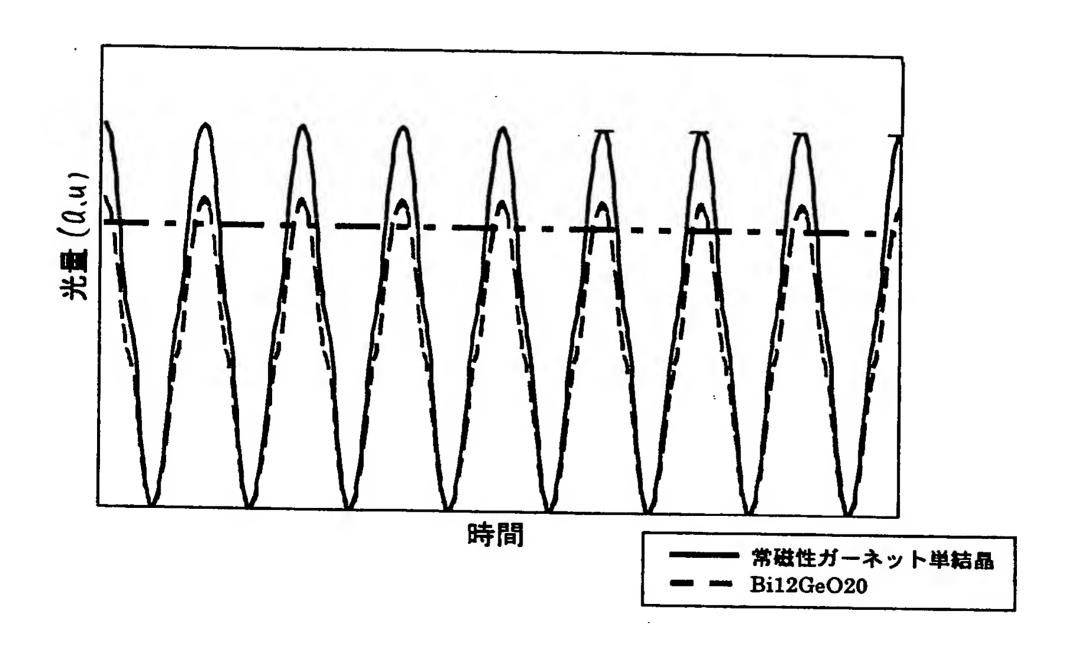
【図8】



【図9】



【図10】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 大電流領域、すなわち磁界強度の高い領域においても、感度が高く、500~650nmといった可視光領域の波長を有する光を用いても感知可能な光磁界センサを提供することにある。

【解決手段】 常磁性体からなるファラデー回転子と、偏光子と、検光子と、 光照射手段と、光感知手段とを具備する光磁界センサであって、前記常磁性体からなるファラデー回転子が少なくともTbとAlとを含む常磁性体ガーネット単 結晶からなることを特徴とする。

【選択図】 図1

## 出願人履歴情報

識別番号

[000006231]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 京都府長岡京市天神二丁目26番10号

氏 名 株式会社村田製作所